

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일

2022년 4월 21일 (21.04.2022)



(10) 국제공개번호

WO 2022/080921 A1

(51) 국제특허분류:

H01L 21/67 (2006.01)

B24B 49/12 (2006.01)

H01L 21/304 (2006.01)

B24B 9/06 (2006.01)

H01L 21/68 (2006.01)

(21) 국제출원번호:

PCT/KR2021/014317

(22) 국제출원일:

2021년 10월 15일 (15.10.2021)

(25) 출원언어:

한국어

(26) 공개언어:

한국어

(30) 우선권정보:

10-2020-0131907 2020년 10월 13일 (13.10.2020) KR

10-2021-0067255 2021년 5월 25일 (25.05.2021) KR

10-2021-0067263 2021년 5월 25일 (25.05.2021) KR

10-2021-0104769 2021년 8월 9일 (09.08.2021) KR

10-2021-0104771 2021년 8월 9일 (09.08.2021) KR

10-2021-0104772 2021년 8월 9일 (09.08.2021) KR

10-2021-0117361 2021년 9월 3일 (03.09.2021) KR

(71) 출원인: (주)미레컴퍼니 (MEERE COMPANY INC.)

[KR/KR]; 18630 경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12, Gyeonggi-do (KR).

(72) 발명자: 정일준 (JUNG, Il Jun); 17720 경기도 평택

시 지산천로 40, 102동 1101호, Gyeonggi-do (KR). 김

기호 (KIM, Ki Ho); 18113 경기도 오산시 삼미로 34,

104동 1001호, Gyeonggi-do (KR). 한정열 (HAN, Jung

Yul); 18457 경기도 화성시 동탄반석로 42, 605동 1202

호, Gyeonggi-do (KR). 이기현 (LEE, Ki Heon); 18111 경

기도 오산시 문시로 183-19, 115동 501호, Gyeonggi-do

(KR). 박지훈 (PARK, Ji Hun); 18500 경기도 화성시 동
탄대로3길 33, 2926동 202호, Gyeonggi-do (KR).

(74) 대리인: 특허법인더웨이브 (THEWAVE IP LAW

FIRM); 06194 서울시 강남구 삼성로85길 32 8층, Seoul
(KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국

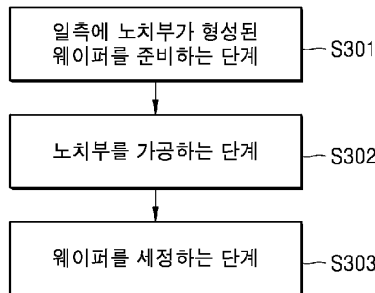
내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,
EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU,
ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW,
KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK,
MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA,
PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역

내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE,
LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유
럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: METHOD, SYSTEM, AND APPARATUS FOR PROCESSING WAFER

(54) 발명의 명칭: 웨이퍼 가공 방법, 시스템 및 장치



S301 ... Step of preparing wafer having notch portion formed on one side thereof

S302 ... Step of processing notch portion

S303 ... Step of washing wafer

(57) Abstract: One embodiment of the present invention provides a method for processing a wafer, the method comprising the steps of: preparing a wafer having a notch portion formed on one side thereof; aligning the wafer by analyzing image information about the notch portion captured by a vision camera; and using a notch wheel to process the notch portion such that a predetermined area of the notch portion has a preset thickness.

(57) 요약서: 본 발명의 일 실시예는, 일측에 노치부가 형성된 웨이퍼를 준비하는 단계, 비전 카메라에 의해 촬영한 상기 노치부의 영상정보를 분석하여 상기 웨이퍼를 정렬하는 단계 및 노치휠을 이용하여 상기 노치부의 일정 영역이 사전에 설정된 두께를 갖도록 상기 노치부를 가공하는 단계를 포함하는 웨이퍼 가공 방법을 제공한다.

[다음 쪽 계속]

공개:

- 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))
- 청구범위 보정 기한 만료 전의 공개이며, 보정서를 접수하는 경우 그에 관하여 별도 공개함 (규칙 48.2(h))
- 국제출원일이 우선기간 만료일로부터 2월 이내임 (규칙 26의2.3)